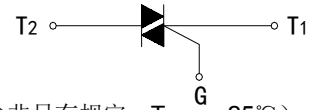


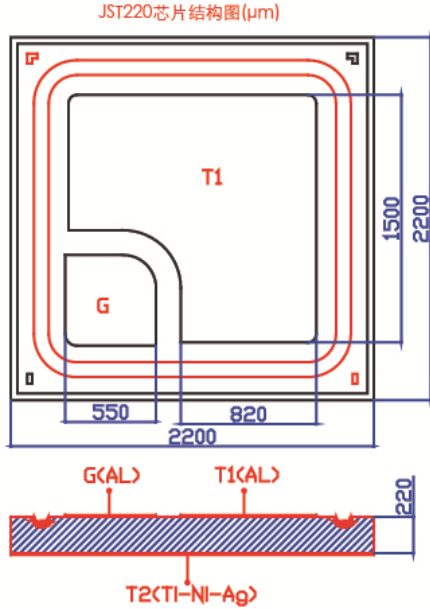
JST220 型三、四象限双向晶闸管芯片

(芯片代码: GP308)

- 芯片特征: 单面台面结构, 台面玻璃钝化工艺, 背面三层金属电极。
- 芯片尺寸: 2.2mm×2.2mm
- 可替换型号: BTA04/BTB04/BT136



○ 产品极限参数 (封装成 TO-220 后, 除非另有规定, $T_{CASE}=25^{\circ}C$)



参数名称	符号	数值	单位
结温范围	T_j	-40~125	$^{\circ}C$
正向断态重复峰值电压	V_{DRM}	600/800	V
反向断态重复峰值电压	V_{RRM}	600/800	V
通态均方根电流 $T_C=110^{\circ}C$	$I_{T(RMS)}$	4	A
通态浪涌电流	I_{TSM}	$tp=20mS$	40
		$tp=16.7mS$	41
i^2t 值 $tp=10mS$	i^2t	8	A^2S
通态电流临界上升率 $I_G=2 \times I_{GT}, tr \leq 100ns, F=100Hz$	di/dt	50	A/uS
门极峰值电流 $T_j=125^{\circ}C$	I_{GM}	4	A
门极平均功率 $T_j=125^{\circ}C$	$P_{G(AV)}$	1	W

○ 产品电性能 (封装成 TO-220 后, 除非另有规定, $T_{CASE}=25^{\circ}C$)

特性和测试条件	符号	数值		单位
		T		
通态峰值电压 $I_{TM}=8.5A, tp=380uS$	V_{TM}	≤ 1.55		V
正向断态峰值电流 $T_C=25^{\circ}C$	I_{DRM1}	≤ 5		μA
$V_D=V_{DRM}$ $T_C=125^{\circ}C$	I_{DRM2}	≤ 1		mA
反向断态峰值电流 $T_C=25^{\circ}C$	I_{RRM1}	≤ 5		μA
$V_R=V_{RRM}$ $T_C=125^{\circ}C$	I_{RRM2}	≤ 1		mA
门极触发电压 $V_D=12V, R_L=30\Omega$	V_{GT}	≤ 1.3		V
门极不触发电压 $V_D=V_{DRM}, R_L=3.3K\Omega, T_j=125^{\circ}C$	V_{GD}	≥ 0.2		V
门极触发电流 $V_D=12V, R_L=30\Omega$	$I_{GT(I-II-III)}$	≤ 5		mA
	$I_{GT(IV)}$	≤ 10		
擎住电流 $I_G=1.2I_{GT}$	$I_L(I-III)$	≤ 10		mA
	$I_L(IV)$	≤ 20		
	$I_L(II)$	≤ 15		
维持电流 $I_T=0.2A$	I_H	≤ 10		mA
断态电压临界上升率 $T_j=125^{\circ}C$ $V_D=2/3V_{DRM}$, 门极开路	dV/dt	≥ 20		V/uS